



## Dr Predrag Krstajić

Viši naučni saradnik



**Adresa:** Centar za mikroelektronske tehnologije, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu, Njegoševa 12, 11000 Beograd

**Telefon:** 011 2628 587

**Faks:** 011 6182 995

**Elektronska pošta:** pkrstajic@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

**Obrazovanje:** 2000 diplomirani elektroinženjer, Univerzitet u Beogradu, Srbija  
2006 doktor nauka, Univerzitet u Antverpenu, Belgija

**Zvanja:** 2000 Istraživač pripravnik  
2012 Viši naučni saradnik

**Profesionalno iskustvo:** 2000 – 2001 Centar za mikroelektronske tehnologije, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju  
2008 – 2010 postdoktorska specijalizacija na Univerzitetu Konkordija, Montreal, Kanada  
2010 – danas Centar za mikroelektronske tehnologije, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

**Oblasti interesovanja:**

- Fizika čvrstog stanja
- Fizika poluprovodnika
- Niskodimenzionalni poluprovodnici i poluprovodničke nanostrukture
- Plazmوني i nanoplazmوني seznori

**Citiranost:** 245 (144 bez autocitata) 02.2016; h index = 8

**Znanje jezika:** Engleski

**Najznačajniji projekti:** 2011 – 2016 Mikro, nano-sistemi i senzori za primenu u elektroprivredi, procesnoj industriji i zaštiti životne sredine (TR 32008), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja republike Srbije

**Izabrane publikacije: Publikovani radovi:**

1. Z. Djuric, P. Krstajic, M. Smiljanic and D. Randjelovic, "The Effect of Diffusion on the Impulse Response of RCE Detector", IEEE Phot. Techn. Lett. 13, 620 (2001).
2. P. Krstajic and F.M. Peeters, "Magnetotunneling of holes through single and double barriers using a multiband treatment", Phys. Rev. B 71, 115321 2005
3. P. M. Krstajic and P. Vasilopoulos, "Integral quantum Hall effect in graphene: Zero and finite Hall field", Phys. Rev. B 83, 075427 2011
4. P. M. Krstajic and P. Vasilopoulos, "Integer quantum Hall effect in gapped single-layer graphene", Phys. Rev. B 86, 115432 2012
5. P. M. Krstajic, P. Vasilopoulos, and M. Tahir, "Spin- and valley-polarized transport through ferromagnetic and antiferromagnetic barriers on monolayer MoS<sub>2</sub>", Physica E 75, 317 2016